SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

TRANSISTOR (PNP)

MARKING:M6



MAXIMUM RATINGS (TA=25℃ unless otherwise noted)

Symbol （符号）	Parameter （参数名称）	Value （额定值）	Units （单位）
VCBO	Collector-Base Voltage （集电极-基极电压）	-50	V
VCEO	Collector-Emitter Voltage （集电极-发射极电压）	-45	V
VEBO	Emitter-Base Voltage （发射极-基极电压）	-5	V
IC	Collector Current -Continuous （集电极电流）	-0.1	A
PC	Collector Power Dissipation （耗散功率）	0.2	W
Tj	Junction Temperature （结温）	150	℃
Tstg	Storage Temperature （储存温度）	-55-150	℃

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25℃unless otherwise specified)

Parameter （参数名称）	Symbol （符号）	Test conditions （测试条件）	MIN （最小值）	TYP （典型值）	MAX （最大值）	UNIT （单位）
Collector-base breakdown voltage 集电极-基极击穿电压	V(BR)CBO	IC= -100μA, IE=0	-50			V
Collector-emitter breakdown voltage 集电极-发射极击穿电压	V(BR)CEO	IC= -1mA, IB=0	-45			V
Emitter-base breakdown voltage 发射极-基极击穿电压	V(BR)EBO	IE=-100μA, IC=0	-5			V
Collector cut-off current 集电极-基极截止电流	ICBO	VCB=-50 V , IE=0			-1	μA
Collector cut-off current 集电极-发射极截止电流	ICEO	VCE=-35V , IB=0			-10	μA
Emitter cut-off current 发射极-基极截止电流	IEBO	VEB=-5V , IC=0			-1	μA
DC current gain 直流电流增益	hFE	VCE=-5V, IC= -1mA	80		600	
Collector-emitter saturation voltage 集电极-发射极饱和压降	VCE(sat)	IC=-100mA, IB= -5mA			-0.3	V
Base-emitter saturation voltage 发射极-基极饱和压降	VBE(sat)	IC=-100mA, IB= -5mA			-1	V

CLASSIFICATION OF hFE

Range	80-200	200-400	400-600	

Typical Characteristics

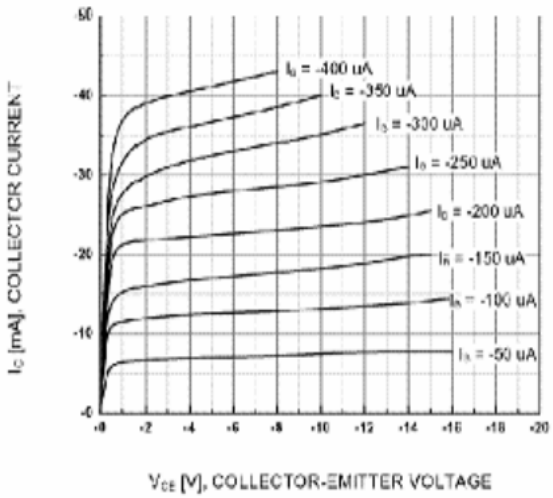


Figure 1. Static Characteristic

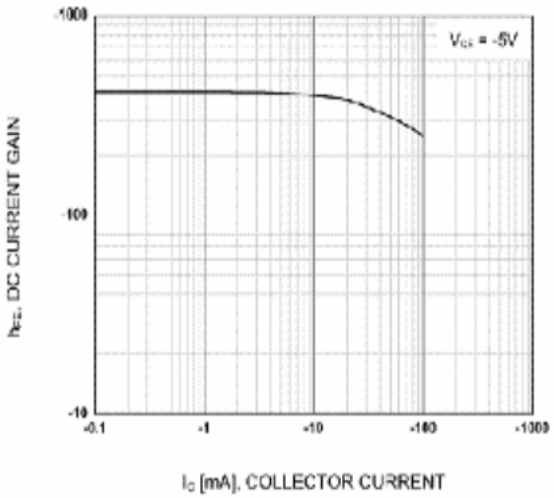


Figure 2. DC current Gain

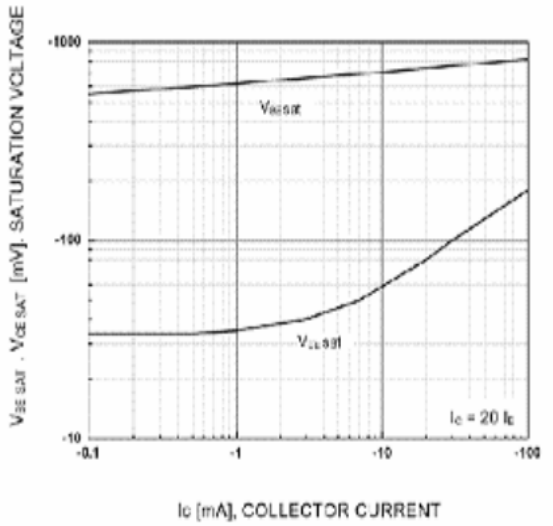


Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

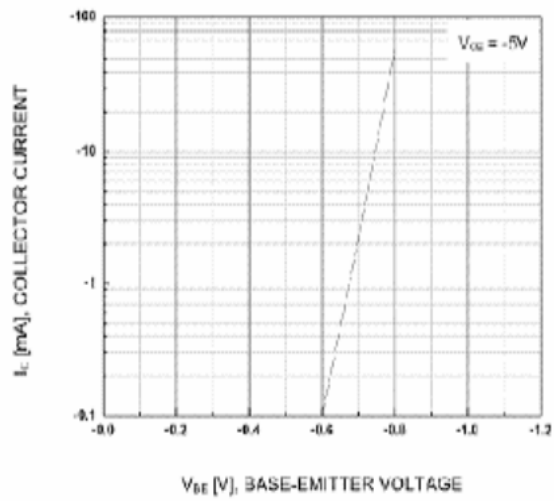


Figure 4. Base-Emitter On Voltage